

Эффекты поверхностной сегрегации на границе электродов из сплавов с растворами электролитов В.А. Сафонов, М.А. Чоба Московский государственный университе

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, кафедра электрохимии

## Основные вопросы

#### Введение

- 1. Поверхностная сегрегация компонентов сплавов на границе металл-вакуум.
- 2. Эффекты поверхностной сегрегации компонентов бинарных сплавов разного фазового состава на границе металл-раствор электролита.
- Методика измерений на механически обновляемых электродах.
- Эвтектические сплавы (Sn-Pb, Ag-Bi).
- Сплавы с ограниченной растворимостью компонентов (Ag-Sn).
- Твердые растворы с неограниченной растворимостью компонентов (Au-Ag).

#### Выводы

## 1. Поверхностная сегрегация компонентов сплавов на границе металл-вакуум

Поверхностная сегрегация - самопроизвольный выход отдельных компонентов сплавов в поверхностный слой.

- каталитические и коррозионные процессы;
- процессы разрушения материалов в агрессивных средах;
- фазовые переходы в многокомпонентных системах;
- разработка специальных методов обработки поверхности металлов;

- решение ряда задач в микроэлектронике и нанотехнологии др.

Основные экспериментальные методы.

- Оже электронная спектроскопия (ЭОС);
- Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) и др.

#### Модельное описание.

- Термодинамический подход;
- Квантово-химические расчеты;
- Методы молекулярной динамики и Монте-Карло.

2. Эффекты поверхностной сегрегации компонентов бинарных сплавов разного фазового состава на границе металл-раствор электролита

- Жидкие бинарные сплавы на основе Ga: Ga-In, Ga-Tl, Ga-Cd, Ga-Pb, Ga-Sn, Ga-Bi Б.Б. Дамаскин, И.А. Багоцкая, В.В. Емец
- Твердые электроды из бинарных сплавов
   Пионерские» работы: Au-Ag Yu. Kukk, J. Clavilier 1977 г.
   Sn-Pb Ю.А. Кукк, Т.Х. Пютсепп 1978 г.

## **Sn-Pb**



Л.П. Хмелевая, Б.Б.Дамаскин, Т.И. Вайнблат, Электрохимия, 1982. Т. 18. С. 1140.

## Конструкция ячейки для измерений на механически обновляемых электродах





- 7-экранирующий бокс.
- 6-к микрометру;
- 5 сапфировый резец;
- 4-к электроду сравнения;
- электрод;
- 3 вспомогательный
- 2-рабочий электрод;
- 1 кварцевая ячейка;



## Фазовая диаграмма сплава Sn-Pb



Емкостные кривые на обновляемых электродах из Sn, Pb и сплава Sn-Pb (1 масс.% Pb) в 0.01 M NaF



Емкостные кривые на обновляемых электродах из Sn, Pb и сплава Sn-Pb (1 масс.% Pb) в 0.01 M NaF



Емкостные кривые на обновляемых электродах из Sn, Pb и сплава Sn-Pb (1 масс.% Pb) в 0.01 M NaF





Fig. 2. C vs E dependences on the renewable electrodes of Sn (1), Sn—Pb alloy (1 wt% Pb) within 1 (2), 5 (3), 10 (4), and 30 (5) min after cutting, and Pb (6). Solution, 0.1 M Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> with addition of cyclohexanol (0.01 M).



Fig. 3. C vs E dependences on renewable electrodes of Sn (1). Sn—Pb alloy (1 wt% Pb) within 1 (2), 10 (3), 15 (4), and 20 (5) min after cutting, and Pb (6). Solution, 0.1 M Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> with addition of camphore  $(2 \times 10^{-3} \text{ M})$ .

## Модель «общего плотного слоя»

$$-C_{\rm H}^{(1)} C_{\rm H}^{(2)} C_{\rm d}$$

$$E(q) = (1 - \theta_{M2})E^{M1}(q) + \theta_{M2}E^{M2}(q)$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1 - \theta_{M2}}{C_1(q)} + \frac{\theta_{M2}}{C_2(q)}$$

## Поверхность сплава Sn-Pb (3 wt.% Pb) в характеристическом рентгеновском излучении



# Модель двумерной поверхностной диффузии

 $\frac{\partial \theta}{\partial t} = D\left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial r^2} + \frac{\partial \theta}{r \partial r}\right),\$  $0 \le r \le r_0, \ 0 \le t \le \infty.$ 

 $\theta(r, t = 0) = 0,$  $\theta(r = r_0, t) = 1$ 

$$\theta(r,t) = 1 - 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\frac{\mu_n r}{r_0})}{\mu_n J_1(\mu_n)} \exp\left(-\frac{\mu_n^2 D}{r_0^2}t\right),$$
  
$$J_0(\mu_n) = 0$$



$$\ln(1-\theta) \approx \ln(4/\mu_1^2) - (\mu_1^2 D / r_0^2)t$$

$$\ln(4/\mu_1^2) \approx -0.36$$

## Временные зависимости степени заполнения поверхности сплава атомами Рb при разных зарядах Sn-Pb (1 wt. % Pb) электрода



 $D \approx 4 \times 10^{-13} - 5 \times 10^{-12} \,\mathrm{cm}^2 \,/\,\mathrm{c}$ 

Зависимость наклона In(1-θ), *t* прямых от заряда электрода из сплава Sn-Pb (1 wt.% Pb) в 0.01 M NaF



## Фазовая диаграмма сплава Ag-Bi





Экспериментальные емкостные кривые на обновляемых электродах из Ag, Bi и Ag-Bi (1 масс.% Bi) в 0.05 M NaF



Модельные емкостные кривые, отвечающие разному количеству атомов Bi (θ от 0 to 1) в поверхностном слое Ag-Bi электрода



# Зависимости In(1-θ) – *t*, характеризующие кинетику поверхностной сегрегации атомов Pb и Bi на обновляемых Sn-Pb и Ag-Bi электродах

Sn-Pb	при	зарядах	х, мкКл/см <sup>2</sup> :
-------	-----	---------	---------------------------

Ag-Bi при потенциалах, B:

1 – (-8),	1 – (-0.8),
2 – (-10),	2 – (-1),
3 – (-13.5),	3 – (-1.2),
4 – (-15).	4 – (-1.3).



### Эквивалентные схемы для расчета величин θ



## Модели поверхностной сегрегации на сплавах эвтектического типа



## Варианты а) - е)

$$\begin{split} \frac{\partial \theta}{\partial t} &= D \Biggl( \frac{\partial^2 \theta}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \theta}{\partial r} \Biggr) \qquad r_1 \le r \le r_2; \ 0 \le t < \infty. \\ \theta(r, t = 0) &= 0; \\ \theta(r = r_1, t) &= 1; \\ \frac{\partial \theta}{\partial r} (r = r_2, t) &= 0. \end{split}$$

$$\theta(r,t) = 1 - \sum_{i=1}^{\infty} e^{-D\lambda_i^2 t} \frac{\pi J_1^2(\lambda_i r_2)}{J_0^2(\lambda_i r_1) - J_1^2(\lambda_i r_2)} \Big[ N_0(\lambda_i r_1) J_0(\lambda_i r) - J_0(\lambda_i r_1) N_0(\lambda_i r) \Big]$$
  
$$J_0(\lambda r_1) N_1(\lambda r_2) - J_1(\lambda r_2) N_0(\lambda r_1) = 0$$

 $\ln(1-\theta) = \ln F(\lambda_1, r_1, r_2) - D\lambda_1^2 t$ 

$$F(\lambda_1, r_1, r_2) = \frac{4J_1^2(\lambda_1 r_2)}{\left[J_0^2(\lambda_1 r_1) - J_1^2(\lambda_1 r_2)\right]\lambda_1^2(r_2^2 - r_1^2)}$$

## Ag-Bi Результаты Оже-электронной спектроскопии

15 мин



Влияние времени с момента прекращения ионного травления на распределение Ві (красные области) по поверхности сплава

### Ag-Bi Распределение атомов Bi по поверхности сплава по данным Оже-электронной спектроскопии



## Фазовая диаграмма сплава Ag–Sn



26



## Емкостные кривые на обновляемых электродах из Ag, Sn и Ag-Sn (3 ат.% Sn) в 0.025 M NaF





Модельные емкостные кривые, отвечающие разному количеству атомов Sn (θ от 0 до 1) в поверхностном слое Ag-Sn (3 ат.% Sn) электрода



$$\frac{1}{C} = \frac{\theta}{C_1(q)} + \frac{1-\theta}{C_2(q)}$$

и разным количествам  $Ag_3Sn$  ( $\theta$  от 0 до 1)



#### Модельное описание временных эффектов на обновляемом Ag-Sn электроде в растворе 0.05 M NaF

#### 2-е уравнение Фика для одномерной полубесконечной диффузии:

$$\frac{\partial N}{\partial t} = D \frac{\partial^2 N}{\partial x^2}, \quad 0 \le x < \infty, \quad 0 \le t < \infty.$$

$$N(x, t = 0) = N_0.$$

$$\frac{\partial N}{\partial x}(x = 0, t) = -h[N(x = 0, t = \infty) - N(x = 0, t)]$$

$$\Phi(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{0}^{z} e^{-\alpha^2} d\alpha$$

$$N(x = 0, t) = 1 - e^{h^2 D t} (1 - N_0) [1 - \Phi(h\sqrt{Dt})]$$

$$\theta(t) = N(x = 0, t)$$

#### РФЭС

Глубина слоя, нм	Концентрация олова, ат. %	Концентрация серебра, ат. %
0.5	11	89
1	6	94
1.5 –2	7.5	92.5
объем	3	97

- N концентрация Sn в атомных долях D – коэффициент объемной диффузии атомов Sn
- x расстояние от поверхности в глубину сплава



## Фазовая диаграмма сплава Au-Ag





Экспериментальные *С*, *Е*-кривые на обновляемых электродах из Au и Ag в растворе поверхностно-неактивного электролита

















## Влияние потенциала на скорость процесса поверхностной сегрегации атомов серебра

Au-Ag



Скорость процесса поверхностной сегрегации атомов серебра зависит от потенциала электрода и существенно возрастает при переходе в область, отвечающую положительным значениям заряда поверхности серебряного электрода и начала адсорбции на нем атомарного кислорода.

#### *С, Е*-кривые на Ag-электроде, относящиеся к разным временам после обновления в растворе электролита



*Е*, В

#### *j*, *E*-зависимости, измеренные от разных потенциалов окисления Ад-электрода



-1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 *E*, B

-2.0

-2.5

500 c - 1000 c 5- - 2000 c



#### Модель диффузионного механизма процесса поверхностной сегрегации атомов серебра на обновляемом электроде из сплава Au-Ag



$$\theta(t) = 1 - e^{h^2 D t} (1 - N_0) \Big[ 1 - \Phi \Big( h \sqrt{D t} \Big) \Big]$$
$$h^2 D = 2 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$
$$D \approx 10^{-19} - 10^{-18} \text{ cm}^2 / \text{s}$$

**D** – коэффициент объемной диффузии атомов  $Ag, cm^2/c$ 

t-время, c

*h* – коэффициент пропорциональности,см<sup>-1</sup> N<sub>0</sub> – объемная концентрация Ag в атомных долях

1. Скорость процесса поверхностной сегрегации атомов серебра растет со смещением потенциала электрода из сплава Au-Ag в положительную сторону. 2. Чем положительнее потенциал выдержки электрода из сплава в растворе после механического обновления, тем раньше наблюдается электролита расхождение экспериментальных  $\theta$ , t – зависимостей и зависимостей, вытекающих из кинетической модели.

Временные эффекты на Au-Ag электроде в подкисленных растворах NaF (по данным метода индуцированного лазерным нагревом температурного скачка потенциала)

## Схема установки



- 1 торец золотой проволоки,
- 2 торец стеклянного капилляра,
- 3 источник потенциала,
- 4 усилитель,
- 5 коаксиальный

вспомогательный электрод,

изготовленный из Pt сетки,

6 – высокочастотный кабель.

Влияние времени контакта с электролитом обновленной поверхности Au-Ag электрода на температурные скачки потенциала





РФЭС. Экспериментальные спектры линий Au 4f<sub>7/2</sub> (a, б) и Ag 3d<sub>5/2</sub> (в, г), полученные при разных углах выхода электронов (50° и 5°)



При переходе к углу выхода эмитированных электронов 5°, который отвечает минимальной толщине анализируемого слоя, оцениваемой расстоянием 0.5 нм от поверхности, сигнала золота практически не обнаруживается. 46

### выводы

- Методика электрохимических измерений на твердых электродах с механически обновляемой поверхностью представляет широкие возможности для исследования кинетики и механизма процессов поверхностной сегрегации на границе сплавов с растворами электролитов.
- На электрохимической границе (по сравнению с границей металл-вакуум), изменяя потенциал электрода, можно изменять скорость, а в некоторых случаях и направление процессов поверхностной сегрегации.

## Спасибо за внимание.